

证书号第 1344688 号



发明专利证书

发明名称: 纵向导通的 GaN 常关型 MISFET 器件及其制作方法

发明人: 刘扬; 杨帆; 张佰君

专利号: ZL 2011 1 0282654.4

专利申请日: 2011 年 09 月 22 日

专利权人: 中山大学

授权公告日: 2014 年 02 月 12 日

本发明经过本局依照中华人民共和国专利法进行审查, 决定授予专利权, 颁发本证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。

本专利的专利权期限为二十年, 自申请日起算。专利权人应当依照专利法及其实施细则规定缴纳年费。本专利的年费应当在每年 09 月 22 日前缴纳。未按照规定缴纳年费的, 专利权自应当缴纳年费期满之日起终止。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。



局长
申长雨

申长雨



证书号第2592417号



发明专利证书

发明名称：一种Si衬底GaN基肖特基势垒二极管器件的三维互联结构及三维互联方法

发明人：刘扬；周桂林；张佰君

专利号：ZL 2014 1 0648060.4

专利申请日：2014年11月14日

专利权人：中山大学

授权公告日：2017年08月22日

本发明经过本局依照中华人民共和国专利法进行审查，决定授予专利权，颁发本证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。

本专利的专利权期限为二十年，自申请日起算。专利权人应当依照专利法及其实施细则规定缴纳年费。本专利的年费应当在每年11月14日前缴纳。未按照规定缴纳年费的，专利权自应当缴纳年费期满之日起终止。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。



局长
申长雨

申长雨



证书号第2809571号



发明专利证书

发明名称：一种纵向导通的 GaN 常关型 MISFET 器件及其制作方法

发明人：刘扬；何亮；杨帆；姚尧；倪毅强

专利号：ZL 2015 1 0029558.7

专利申请日：2015 年 01 月 21 日

专利权人：中山大学

授权公告日：2018 年 02 月 09 日

本发明经过本局依照中华人民共和国专利法进行审查，决定授予专利权，颁发本证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。

本专利的专利权期限为二十年，自申请日起算。专利权人应当依照专利法及其实施细则规定缴纳年费。本专利的年费应当在每年 01 月 21 日前缴纳。未按照规定缴纳年费的，专利权自应当缴纳年费期满之日起终止。

专利书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。



局长
申长雨

申长雨



证书号第2948032号



发明专利证书

发明名称：一种横向导通的 GaN 常关型 MISFET 器件及其制作方法

发明人：刘扬;何亮;倪毅强;姚尧;杨帆

专利号：ZL 2015 1 0029547.9

专利申请日：2015 年 01 月 21 日

专利权人：中山大学

地址：510275 广东省广州市新港西路 135 号

授权公告日：2018 年 06 月 05 日

授权公告号：CN 104638010 B

本发明经过本局依照中华人民共和国专利法进行审查，决定授予专利权，颁发本证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。

本专利的专利权期限为二十年，自申请日起算。专利权人应当依照专利法及其实施细则规定缴纳年费。本专利的年费应当在每年 01 月 21 日前缴纳。未按照规定缴纳年费的，专利权自应当缴纳年费期满之日起终止。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。



局长
申长雨

申长雨



证书号第2951365号



发明专利证书

发明名称：一种 GaN 基凹槽栅 MISFET 的制备方法

发明人：刘扬;李柳暗

专利号：ZL 2016 1 0168348.0

专利申请日：2016 年 03 月 23 日

专利权人：中山大学

地址：510275 广东省广州市新港西路 135 号

授权公告日：2018 年 06 月 05 日

授权公告号：CN 105679679 B

本发明经过本局依照中华人民共和国专利法进行审查，决定授予专利权，颁发本证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。

本专利的专利权期限为二十年，自申请日起算。专利权人应当依照专利法及其实施细则规定缴纳年费。本专利的年费应当在每年 03 月 23 日前缴纳。未按照规定缴纳年费的，专利权自应当缴纳年费期满之日起终止。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。



局长
申长雨

申长雨



证书号第4091801号



实用新型专利证书

实用新型名称：一种 GaN 基异质结肖特基二极管器件

发 明 人：刘扬;钟健;姚尧

专 利 号：ZL 2014 2 0375894.8

专利申请日：2014 年 07 月 08 日

专 利 权 人：中山大学

授权公告日：2015 年 01 月 21 日

本实用新型经过本局依照中华人民共和国专利法进行初步审查，决定授予专利权，颁发本证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。

本专利的专利权期限为十年，自申请日起算。专利权人应当依照专利法及其实施细则规定缴纳年费。本专利的年费应当在每年 07 月 08 日前缴纳。未按照规定缴纳年费的，专利权自应当缴纳年费期满之日起终止。

专利书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。



局长
申长雨

申长雨



证书号第 5778055 号



实用新型专利证书

实用新型名称：一种高质量 MIS 结构的 AlNGaN 基场效应晶体管

发 明 人：刘扬;王文静;何亮

专 利 号：ZL 2016 2 0385916.8

专利申请日：2016 年 05 月 03 日

专 利 权 人：中山大学

授权公告日：2016 年 12 月 14 日

本实用新型经过本局依照中华人民共和国专利法进行初步审查，决定授予专利权，颁发本证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。

本专利的专利权期限为十年，自申请日起算。专利权人应当依照专利法及其实施细则规定缴纳年费。本专利的年费应当在每年 05 月 03 日前缴纳。未按照规定缴纳年费的，专利权自应当缴纳年费期满之日起终止。

专利书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。



局长
申长雨

申长雨



证书号第 7643673 号



实用新型专利证书

实用新型名称：一种高性能常关型的 GaN 场效应晶体管

发 明 人：刘扬;郑介鑫

专 利 号：ZL 2017 2 1420258.2

专利申请日：2017 年 10 月 30 日

专 利 权 人：中山大学

地 址：510275 广东省广州市新港西路 135 号

授权公告日：2018 年 07 月 27 日

授权公告号：CN 207664047 U

本实用新型经过本局依照中华人民共和国专利法进行初步审查，决定授予专利权，颁发本证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。

本专利的专利权期限为十年，自申请日起算。专利权人应当依照专利法及其实施细则规定缴纳年费。本专利的年费应当在每年 10 月 30 日前缴纳。未按照规定缴纳年费的，专利权自应当缴纳年费期满之日起终止。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。



局长
申长雨

申长雨



证书号第 7649390 号



实用新型专利证书

实用新型名称：一种高质量 MOS 界面的常关型 GaNMOSFET 结构

发 明 人：刘扬;阙陶陶

专 利 号：ZL 2017 2 1427178.X

专利申请日：2017 年 10 月 31 日

专 利 权 人：中山大学

地 址：510275 广东省广州市新港西路 135 号

授权公告日：2018 年 07 月 27 日

授权公告号：CN 207664049 U

本实用新型经过本局依照中华人民共和国专利法进行初步审查，决定授予专利权，颁发本证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。

本专利的专利权期限为十年，自申请日起算。专利权人应当依照专利法及其实施细则规定缴纳年费。本专利的年费应当在每年 10 月 31 日前缴纳。未按照规定缴纳年费的，专利权自应当缴纳年费期满之日起终止。

专利书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。



局长

申长雨

申长雨



证书号第 7939276 号



实用新型专利证书

实用新型名称：一种高阈值电压高导通性能的常关型 GaN 基 MOSFET 结构

发 明 人：刘扬;张佳琳

专 利 号：ZL 2017 2 1450554.7

专利申请日：2017 年 11 月 03 日

专 利 权 人：中山大学

地 址：510275 广东省广州市新港西路 135 号

授权公告日：2018 年 10 月 12 日

授权公告号：CN 207966998 U

本实用新型经过本局依照中华人民共和国专利法进行初步审查，决定授予专利权，颁发本证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。

本专利的专利权期限为十年，自申请日起算。专利权人应当依照专利法及其实施细则规定缴纳年费。本专利的年费应当在每年 11 月 03 日前缴纳。未按照规定缴纳年费的，专利权自应当缴纳年费期满之日起终止。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。



局长
申长雨

申长雨



证书号第 8393681 号



实用新型专利证书

实用新型名称：一种高耐压高导通性能 P 型栅极常关型 HEMT 器件

发 明 人：刘扬;陈佳;李柳暗

专 利 号：ZL 2018 2 0916109.3

专利申请日：2018 年 06 月 13 日

专 利 权 人：中山大学

地 址：510275 广东省广州市新港西路 135 号

授权公告日：2019 年 01 月 22 日

授权公告号：CN 208422921 U

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法经过初步审查，决定授予专利权，颁发实用新型专利证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为十年，自申请日起算。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。



局长
申长雨

申长雨

